

[首页](#)[机构](#)[成果](#)[学者](#)

# 中国科学院机构知识库网格

Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid

[登录](#) [注册](#)

CAS IR Grid / 上海应用物理研究所 / 中国科学院上海应用物理研究所 / 中科院上海应用物理研究所2004-2010年

## 生长纳米级气泡的方法及其观察并控制装置与方法

文献类型: 专利

入库方式: OAI收割

来源: [上海应用物理研究所](#)

浏览	下载	收藏
327	85	0

**作者** 张立娟; 胡钧; 方海平; 樊春海; 张益; 沈广霞

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**中文摘要** 本发明公开了一种生长纳米级气泡的方法, 其采用电化学方法, 以疏水的、表面粗糙度不超过10纳米的导电材料为工作电极, 同时作为生长纳米气泡的基底, 并控制电压至少为0.7V的正压或负压, 反应时间为1秒~2.5小时。本发明也公开了一种观测并控制上述生长纳米级气泡的装置和方法。本发明方法可以产生某一单体成分的纳米级气泡, 具有很好重现性, 操作简便; 而且, 通过改变电压和反应时间可以控制纳米气泡的大小和数量。

**学科主题** G01N13/00 ; G01N1/28 ; C25B1/00

**公开日期** 2013-01-23

**语种** 中文

**专利申请号** CN200510111757

**专利代理** 薛琦

**源URL** [<http://ir.sinap.ac.cn/handle/331007/10576>]

**专题** 上海应用物理研究所\_中科院上海应用物理研究所2004-2010年

**推荐引用方式** 张立娟,胡钧,方海平,等. 生长纳米级气泡的方法及其观察并控制装置与方法.  
**GB/T 7714**

[其他版本](#)

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

[欧盟学术资源开放存取平台](#) | [CALIS高校机构知识库](#) | [台湾学术机构典藏](#) | [香港机构知识库整合系统](#) | [网站地图](#) | [意见反馈](#)

版权所有 ©2023 中国科学院 - 运行维护: 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace

[0931-8270076发送邮件](#)

陇ICP备2021001824号-8

甘公网安备 62010202001088号